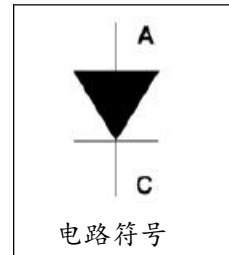


KD980

特点:

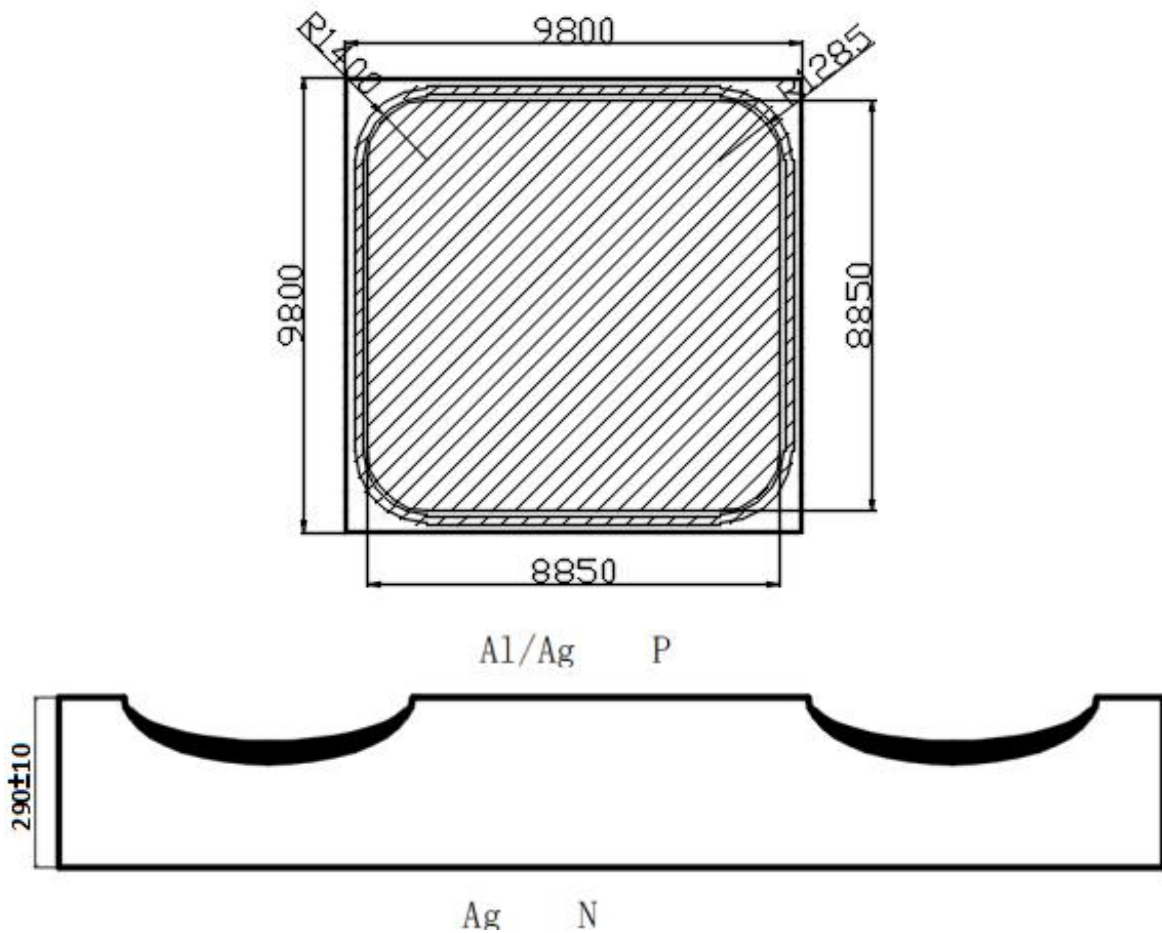
- 阻断电压高 (>1800V)
- 低正向压降; 高通态电流 I_F
- 复合钝化台面结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高



应用:

主要应用于各类电力电子模块等。

外形尺寸图:



单位: 微米

极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{RRM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_R=0.1\text{mA}$			1800	V
V_{RSM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_R=0.1\text{mA}$			1900	V
$I_{F(AV)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$			120	A
I_{FSM}	$T_j=45^{\circ}\text{C}$, $t=10\text{ms}$, $\sin 180^{\circ}$			1800	A
T_j		-40		150	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_{RRM}	$V_{RRM}=1800\text{V}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	10	μA
	$V_{RRM}=1800\text{V}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	2.2	mA
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_F=84\text{A}$	-	-	1.21	V
$V_{(TO)}$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	0.85	V
R_T	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-		1.6	m Ω